薄膜結晶成長シミュレーションによる REBCO 薄膜中 BMO の 自己組織化メカニズムの検討

Investigation for BMO self-organization within REBCO thin film

by means of thin film growth simulation

名大工コ研¹,名大院工² O一野 祐亮^{1,2},吉田 隆²

EcoTopia Science Institute, Nagoya Univ.¹, Nagoya Univ.² ^oY. Ichino^{1,2}, Y. Yoshida²

E-mail: ichino@nuee.nagoya-u.ac.jp

1. はじめに

BaMO₃ (BMO, M=Zr, Sn, Hf など)を添加した REBa₂Cu₃O₂ (REBCO, RE=Y, Sm, Gd など)薄膜をパ ルスレーザー蒸着(PLD)法などの気相法で作製した 場合、BMO が REBCO 中で自己組織化し、ナノロ ッドやナノパーティクルを形成する[1]。これらは量 子化磁束のピンニングセンターとして非常に効果的 であり、磁場中における臨界電流密度(J_)を大幅に向 上させる。しかし、この自己組織化の詳細なメカニ ズムは明らかにされていない。自己組織化のメカニ ズムを明らかにし、制御することができれば磁場中 J.のさらなる向上が期待できる。本研究では、BMO の自己組織化メカニズムを明らかにする事を目的と して、モンテカルロ法を用いて2相混合薄膜の結晶 成長シミュレーションを行った。

2. シミュレーションモデル

図1に示したように、一辺0.4 nmの立方体が三つ 重なったA粒子と立方体一つから成るB粒子が基板 表面に吸着し、ランダムウォークするモデルを考え る。ここで、基板はA粒子で構成されているとした。 基板上のある配置 i に吸着した粒子をランダムに移 動させ配置fにした場合、iの配置エネルギー $E_i \ge f$ の配置エネルギー E_f の差 $\Delta E = E_i - E_f$ が負の場合にはf に移動させ、正ならば $exp(-\Delta E/k_BT_s)$ の確率で f に移 動させた。ここでkBはボルツマン定数、Tsは基板温 度である。配置エネルギーとして、隣接粒子と下地 粒子との間の結合エネルギーEAA、EBBそしてEABを



Fig. 1 Schematic drawing of 3D Monte Carlo model in this study. The substrate consists of the A particles.



Fig. 2 Simulation result for the case of $E_{AA} = 2,000$ K, $E_{BB} =$ 3,000 K, $E_{AB} = 500$ K, $E_{des} = 50,000$ K and $T_s = 1,023$ K. The volume fraction of the B particles is 3.0%. We made the Aparticles transparent in this figure.

用いた。また、粒子は $exp(-E_{des}/k_BT_s)$ の確率で蒸発す るとした。ここで Edes は脱離エネルギーであり気相 粒子と固相粒子間の化学ポテンシャル差に相当する。 3. シミュレーション結果及び考察

図2にシミュレーション結果の一例を示す。図の 条件ではB 粒子が自己組織化し、ナノロッド状に成 長した。その数密度 σ =約3,900/µm²、直径 d =約 3.2 nm であった。実際の試料においては、3.0 vol.%BHO 添加 SmBCO 薄膜を T_s = 1,023 K で作製し た場合、 $\sigma = 約2,300 / \mu m^2$ 、d = 約6 nm であり、シ ミュレーション結果と完全に一致はしないものの同 じオーダーであった。また、図2では基板表面に対 して垂直に成長しているナノロッドに混じって、傾 いて成長しているナノロッドも見られた。実際の試 料においても、T_s = 1,023 K の比較的低い温度では BHO ナノロッドが傾いて成長している結果が得ら れている。以上から、本シミュレーションで自己組 織化を大まかに再現出来たと言える。

謝辞

本研究の一部は科学研究費補助金(23226014 及び 25289358)からの助成を受けて実施したものである。 参考文献

[1] J. L. M-Driscoll et al., Nat. Mater. 3 (2004) 439